

3. Speicher

Programmierung für alle bipolaren PROM

- Hersteller stellt alle Speicherzellen auf »H«;
- U_{CC} und Masse anschließen;
- Adresse des zu programmierenden Wortes an Adreßanschlüsse anlegen, Adreßanschlüsse auf festes Potential legen (!);
- Auswahl des Schaltkreises durch Nichtaktivieren (!) mit CS, H an CS1 oder CS2;
- Programmierimpuls (+21 V) an den entsprechenden Ausgang anlegen; die anderen Ausgänge offen lassen oder an H legen. Es darf nur ein Ausgang programmiert werden.

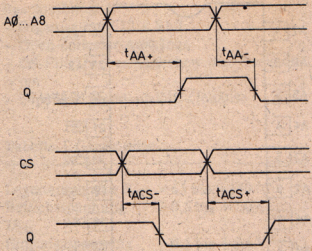


Bild 4
Zeitdiagramm

Tabelle 4 Daten zum Programmieren

	Symbol	Einheit	min. Wert	empfohlener Wert	max. Wert
Adreßeingänge*	U_{IH}	V	2,4	5,0	5,0
	U_{IL}	V	0	0	0,4
Chip Select			2,4	5,0	5,0
Programmierspannung	U_{OP}	V	20	21	21
Programmierimpulsbreite	t_{PW}	ms	0,05	0,18	50
Programmierimpulsanstiegszeit	t_r	µs	0,5	1,0	3,0
Programmierimpulsanzahl			1	4	8
Betriebsspannung	U_{CC}	V	4,75	5,0	5,25
Betriebstemperatur	ϑ_c	°C		25	85
Programmierimpulsstrom	I_{OP}	mA			100

* Anschlüsse während des Programmierens nicht unbeschaltet lassen.